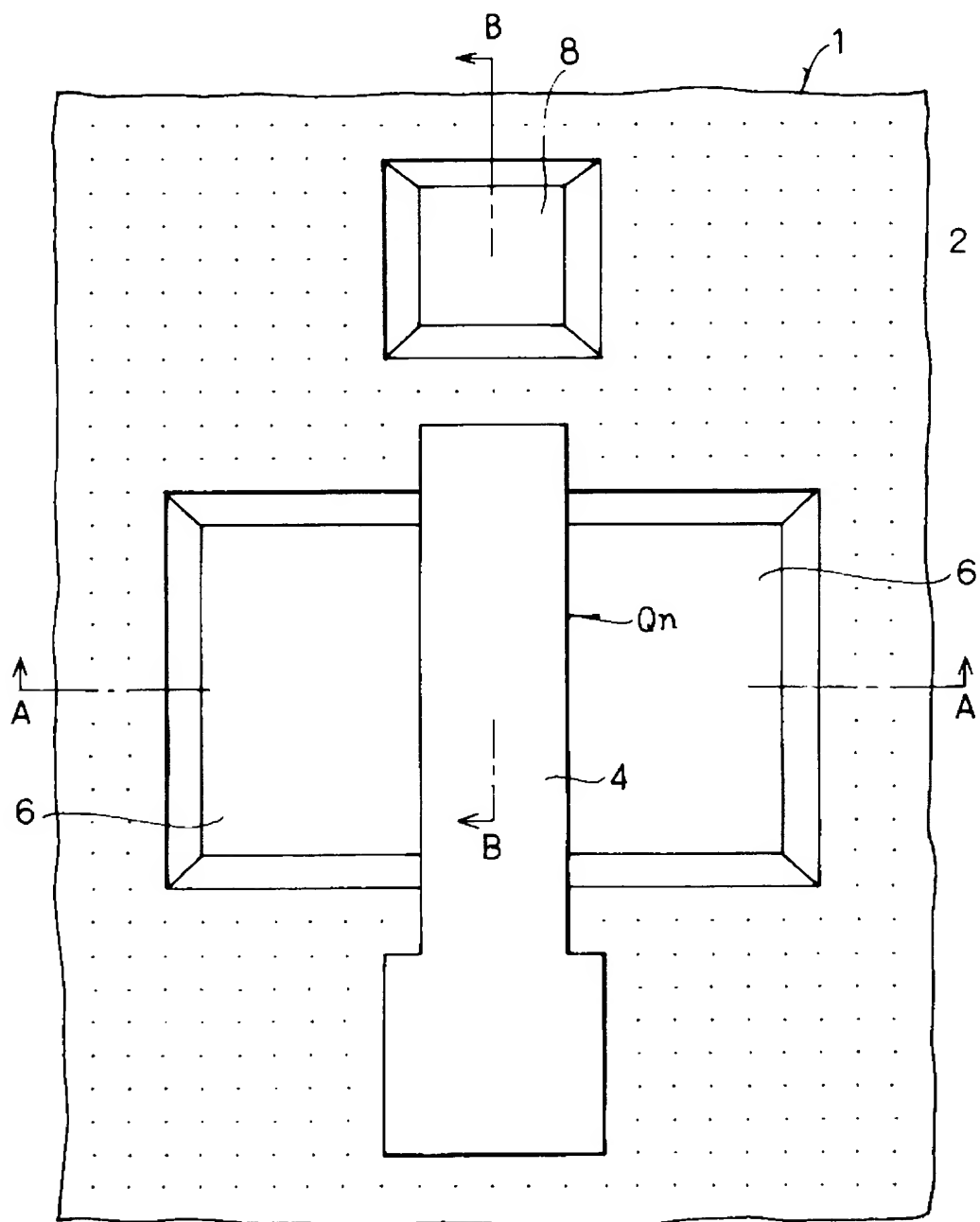
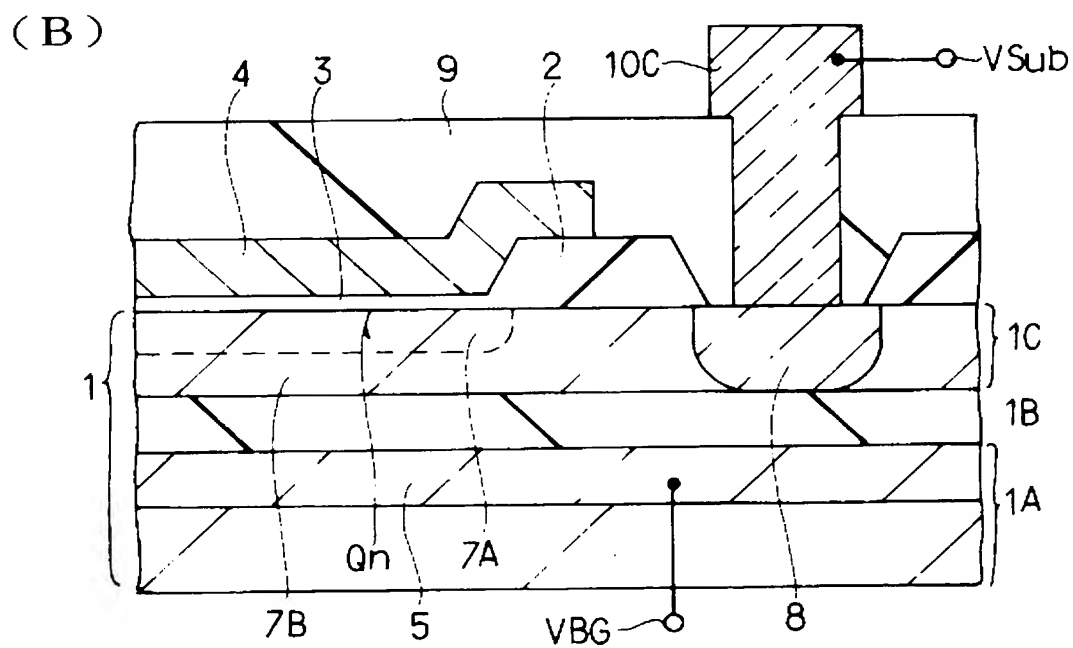


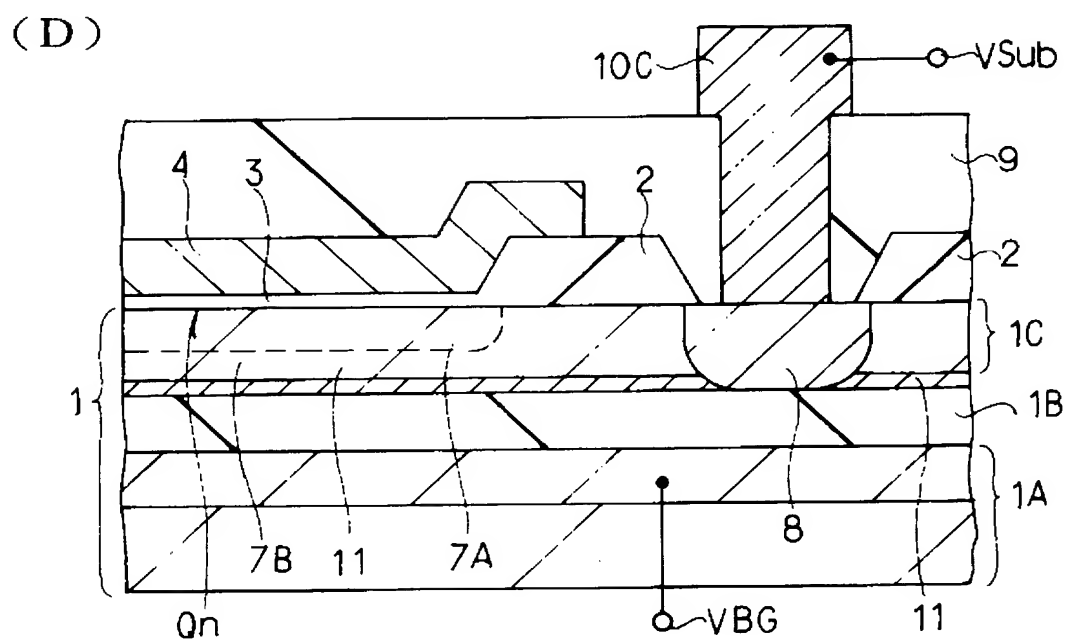
OIPF
JUN 24 2003
PATENT & TRADE MARK

【図1】

図 1

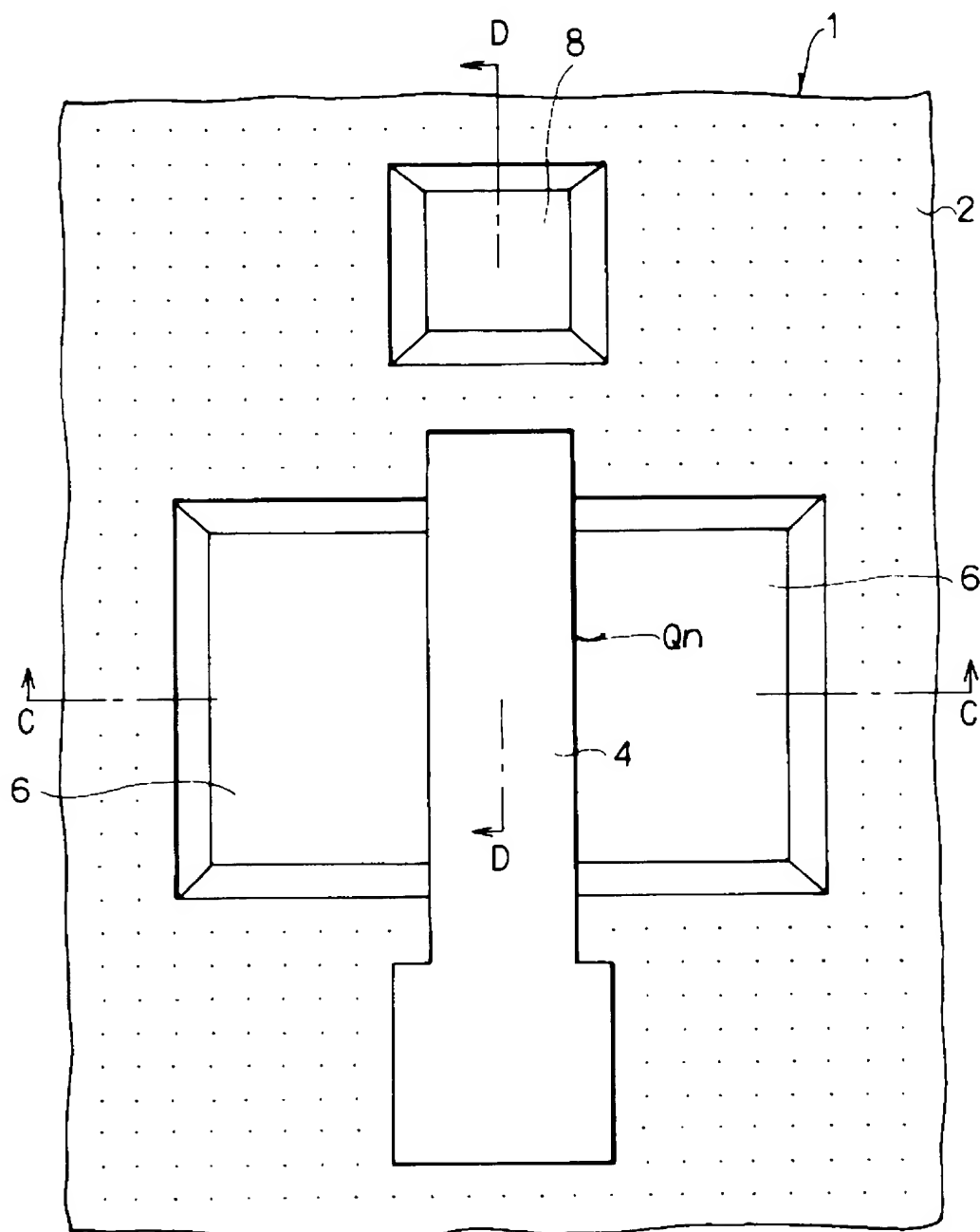






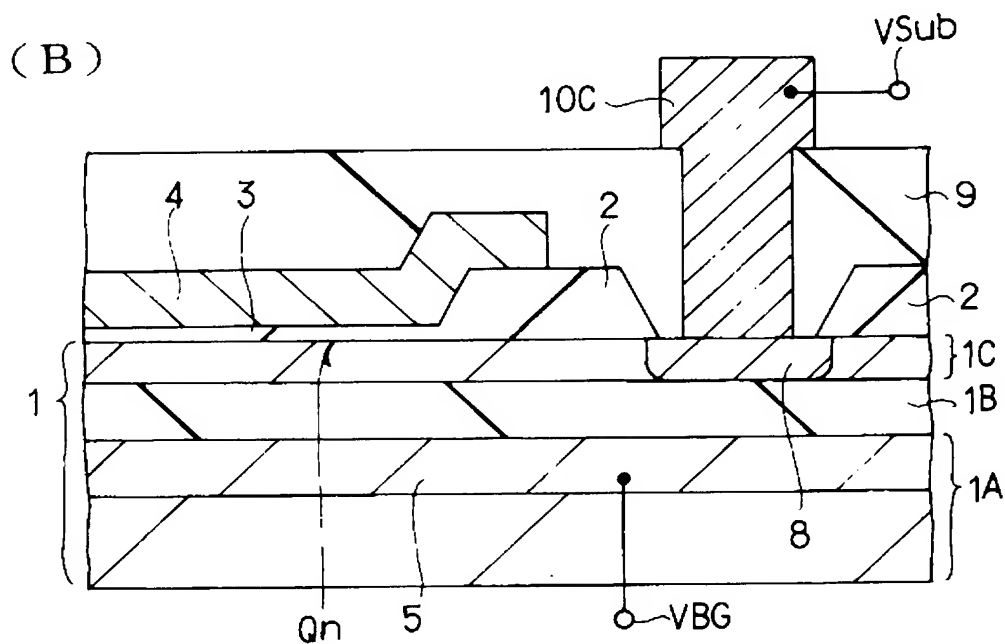
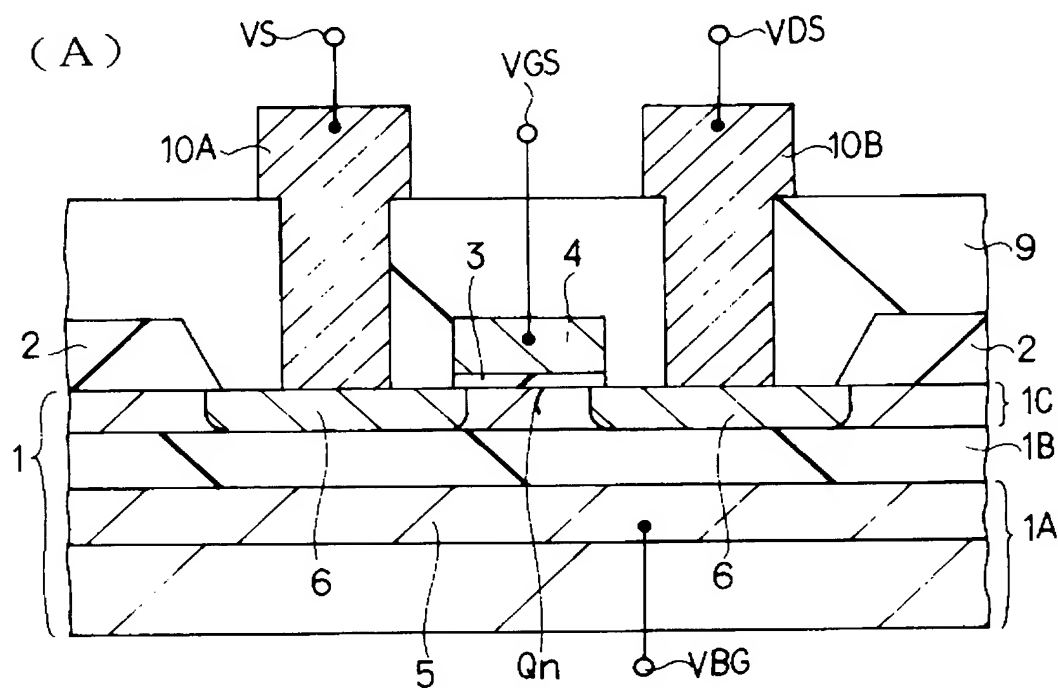
PATENT & TRADE MARK

図 4



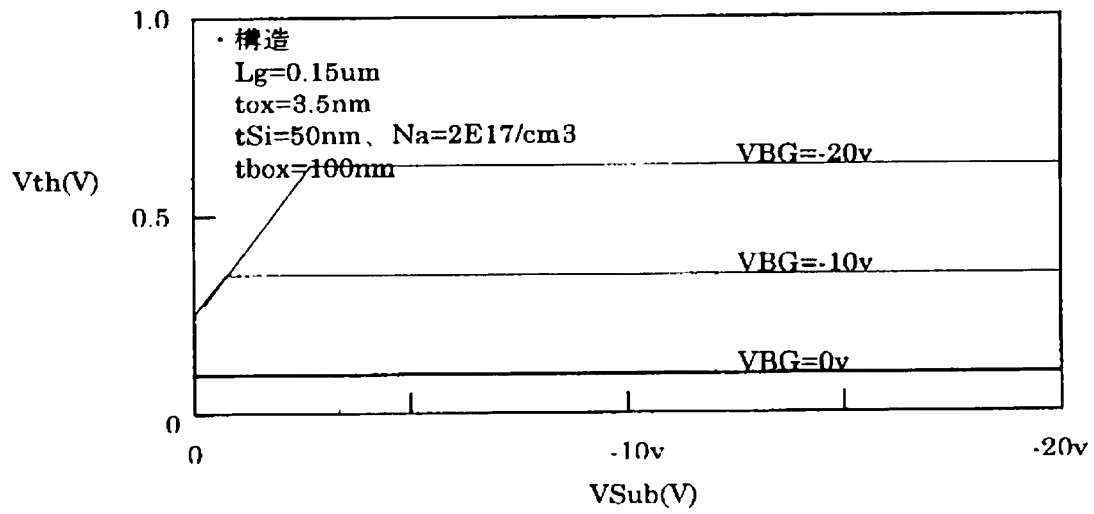
【図5】

図 5



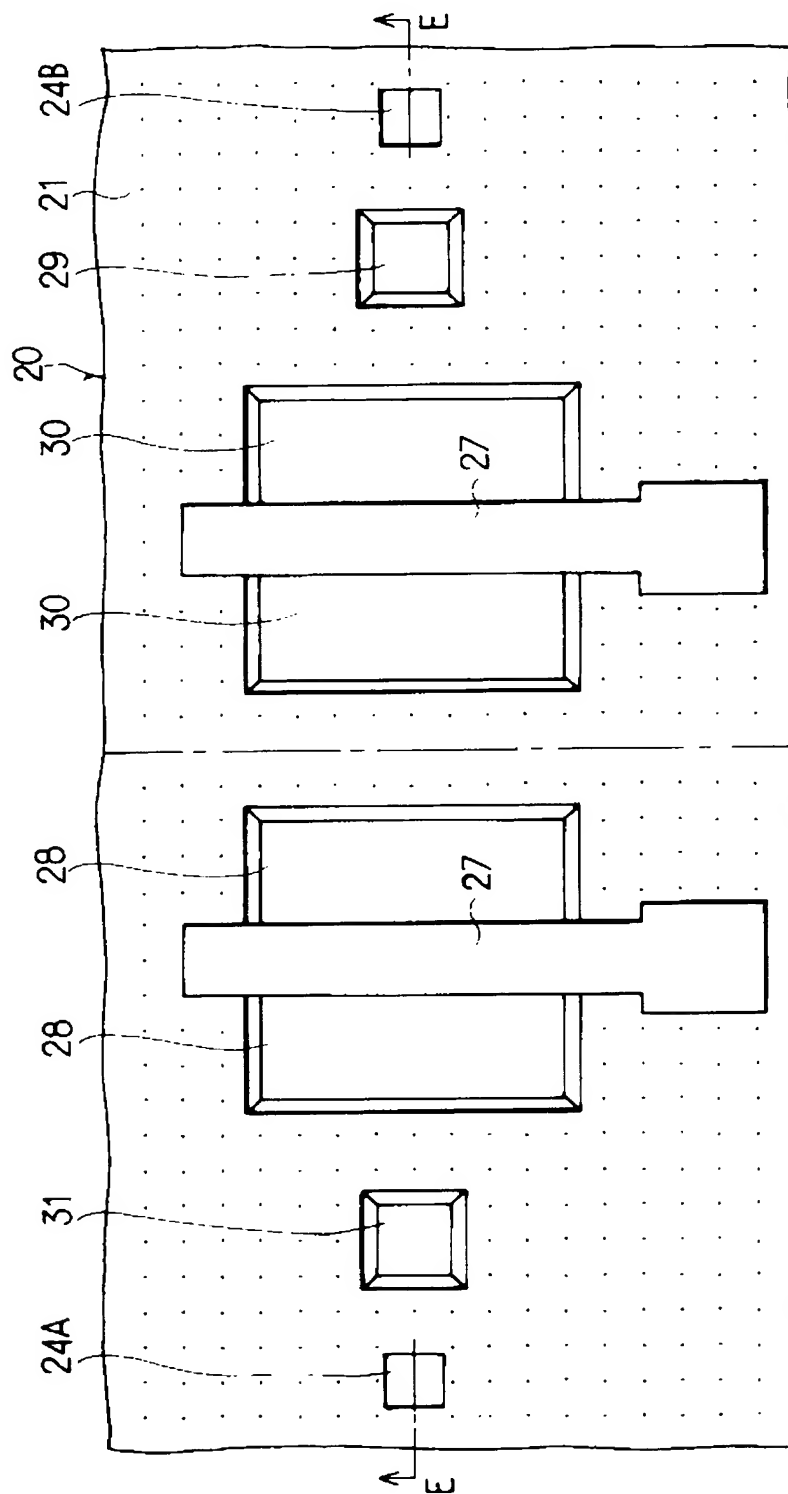
【図6】

図 6



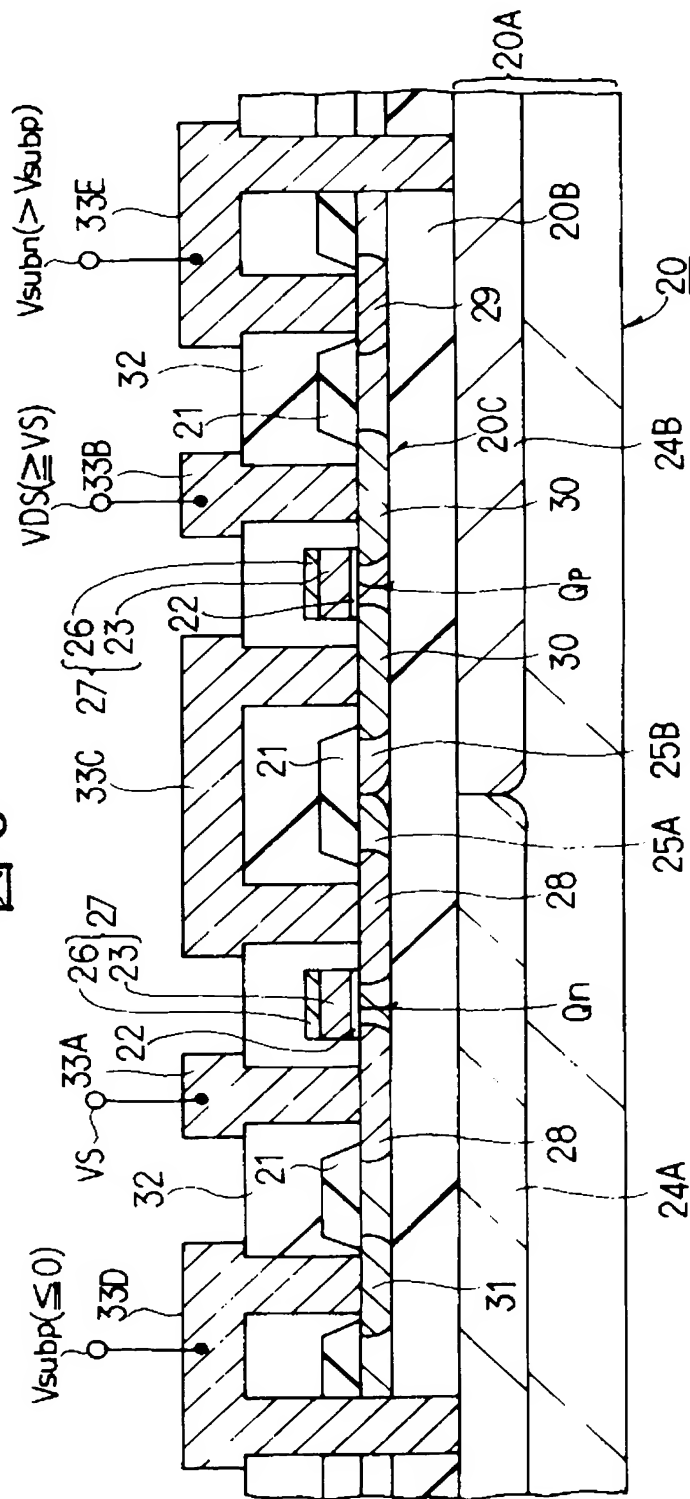
【図7】

図7



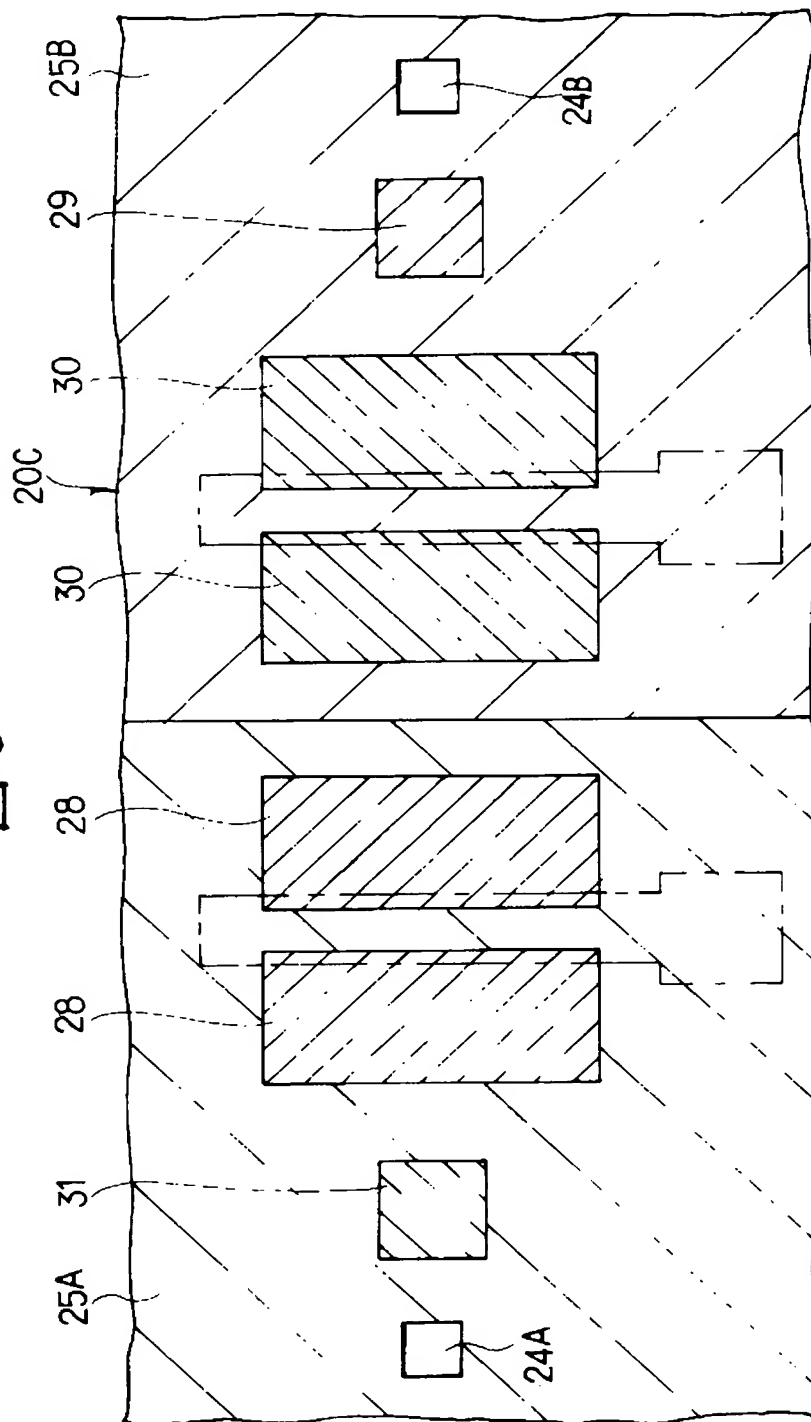
【図8】

図8



【図9】

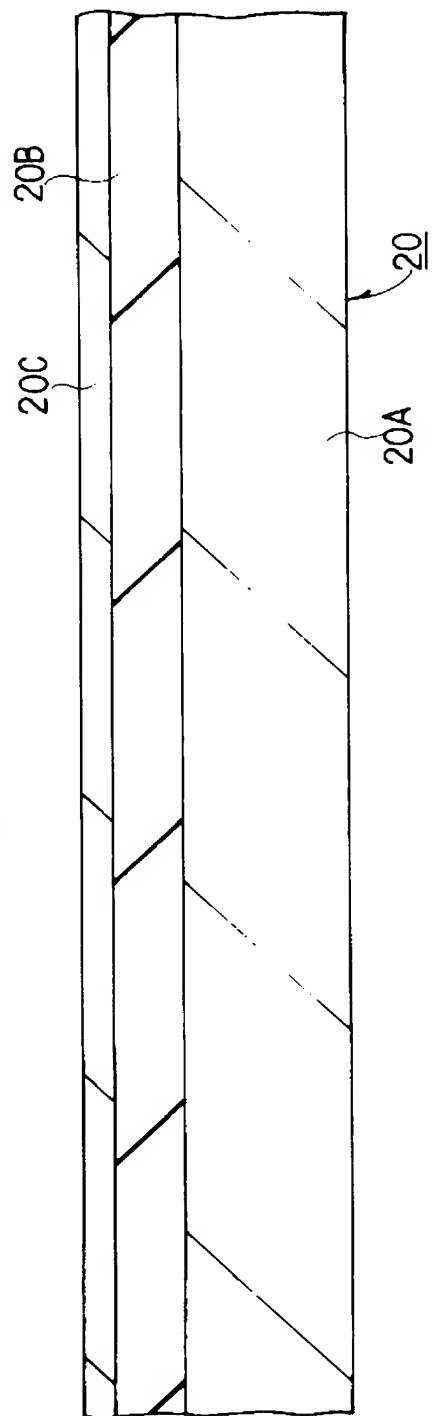
図9



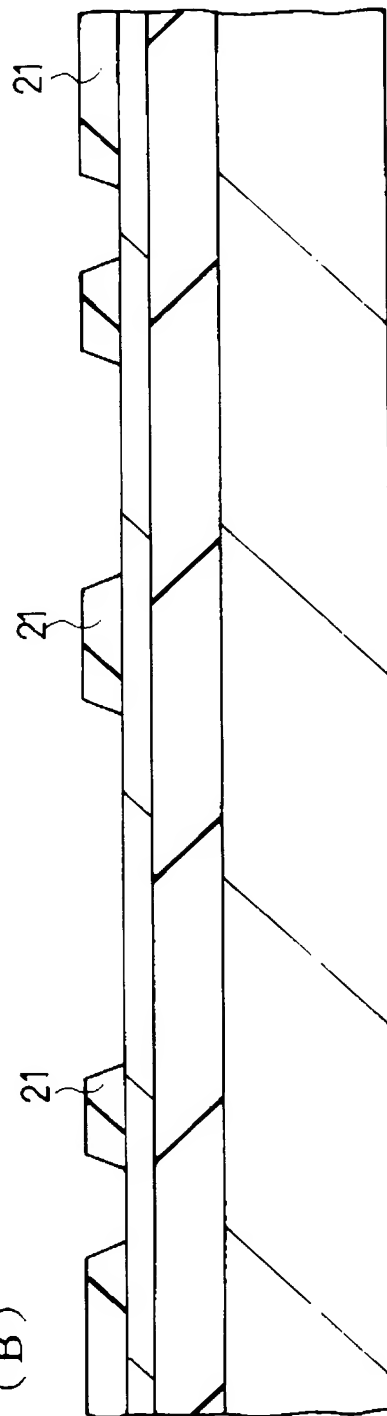
【図10】

図10

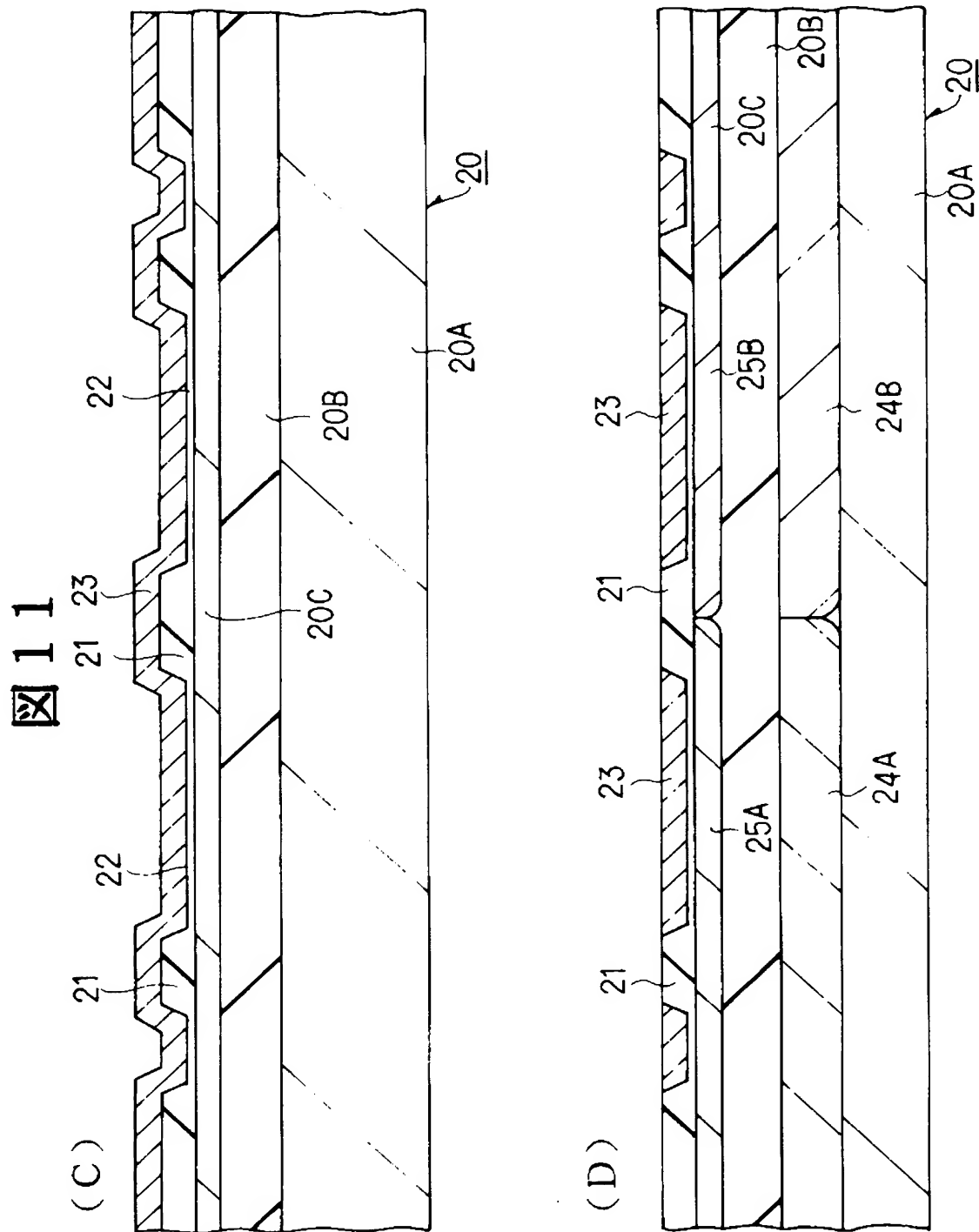
(A)



(B)

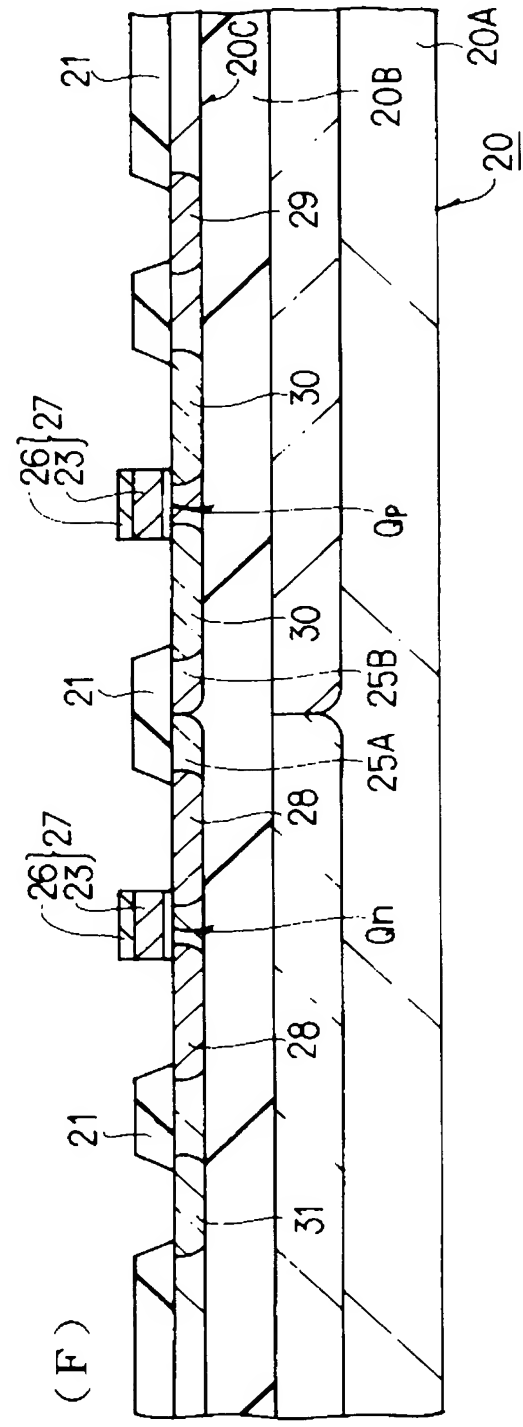
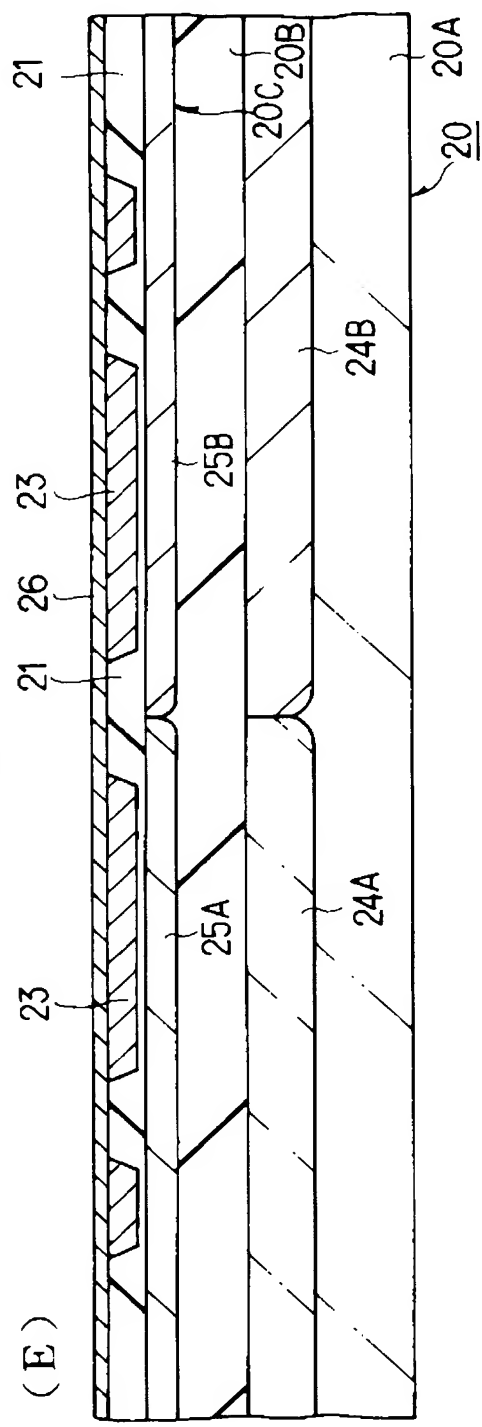


【図11】

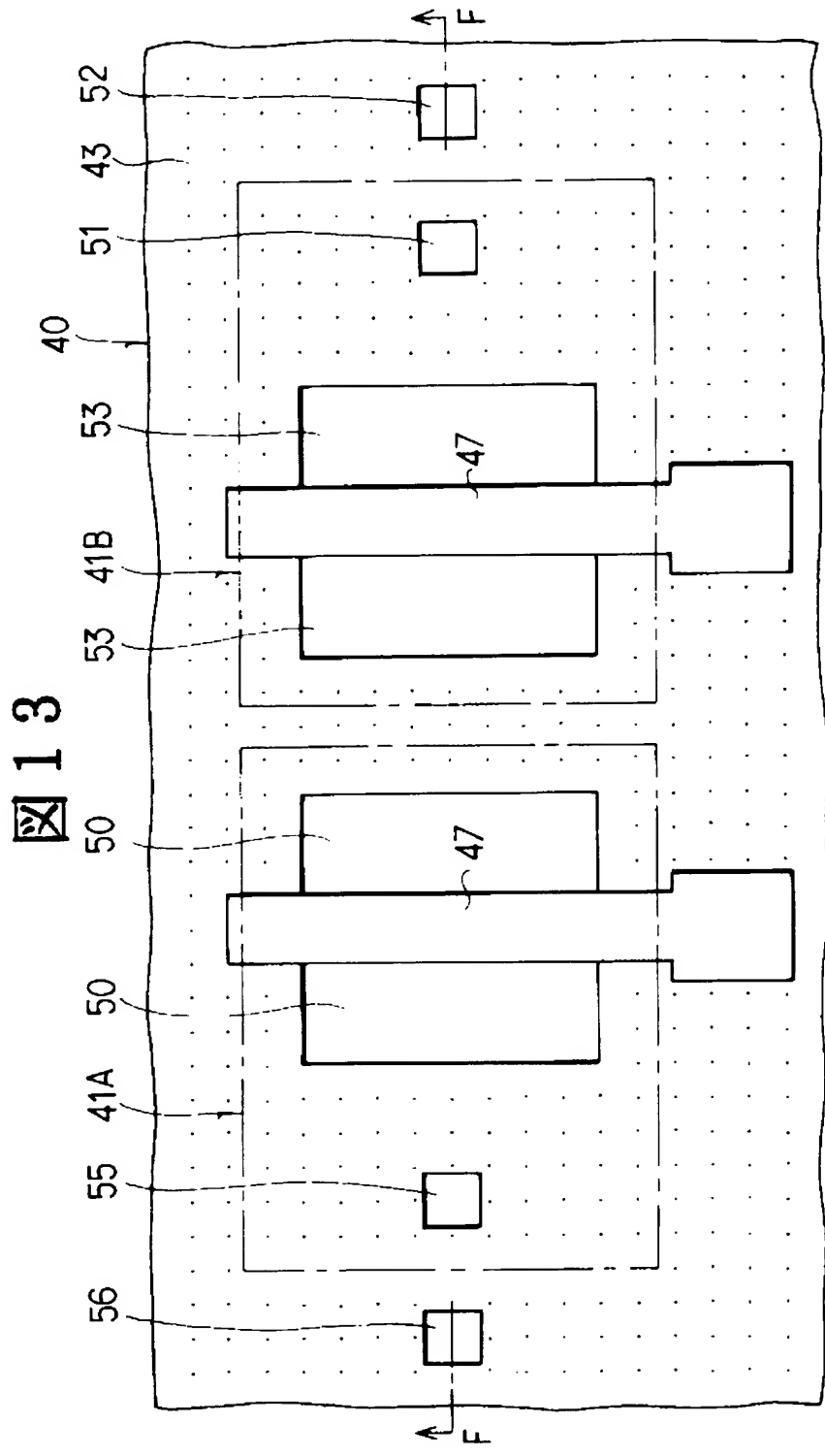


【図12】

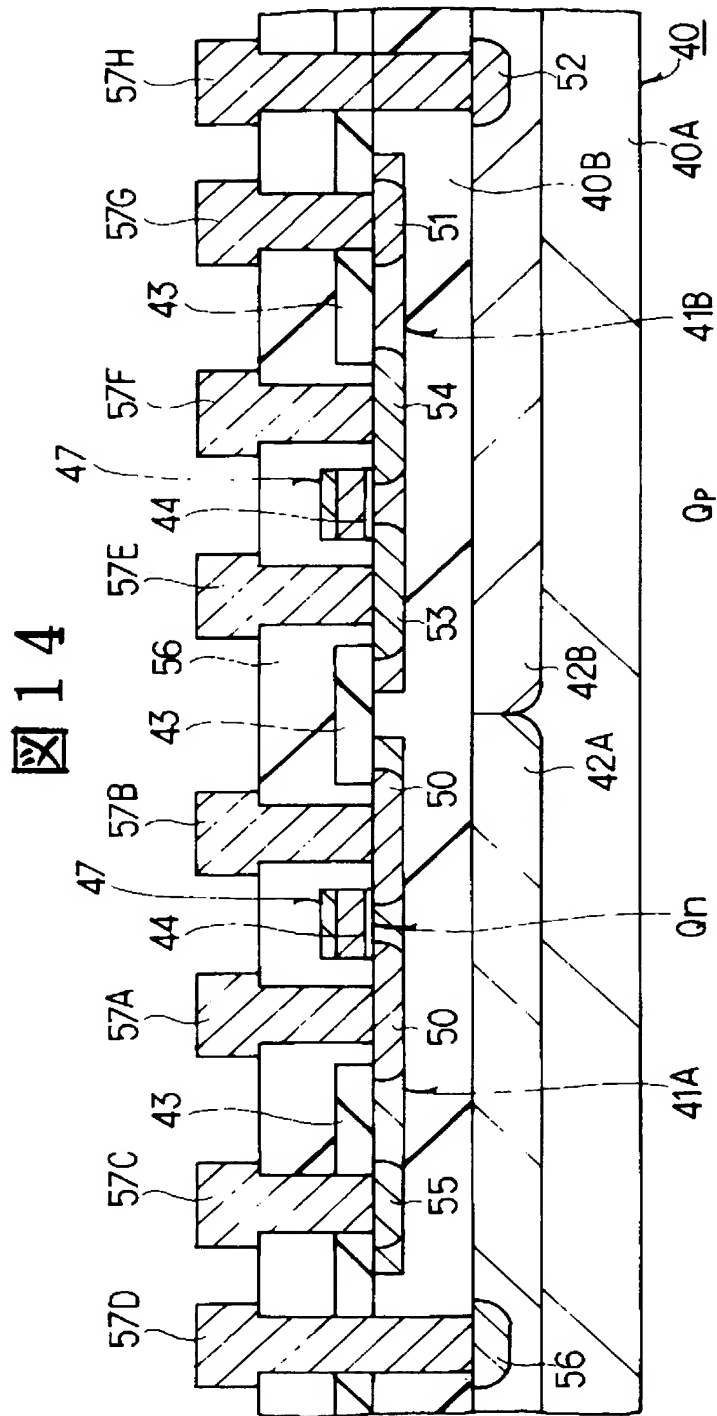
図12



【図13】



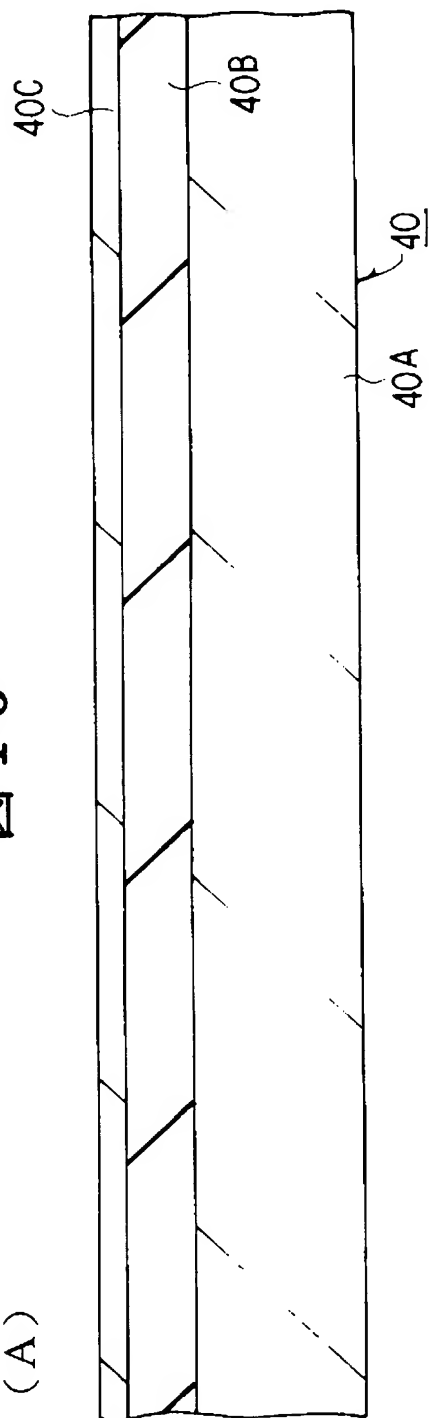
【図14】



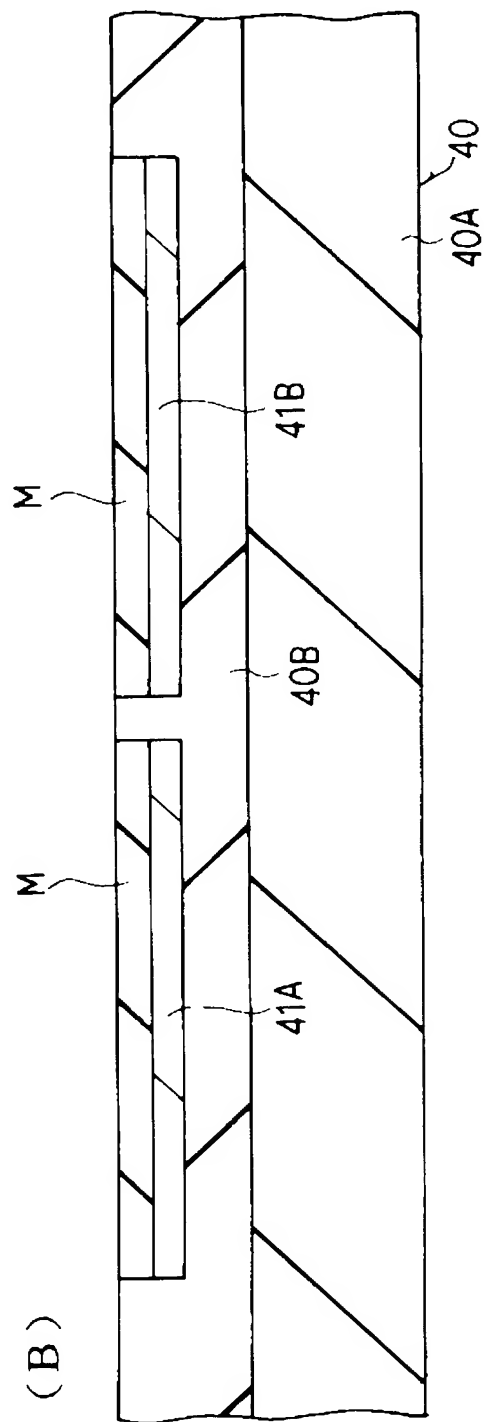
【図15】

図15

(A)



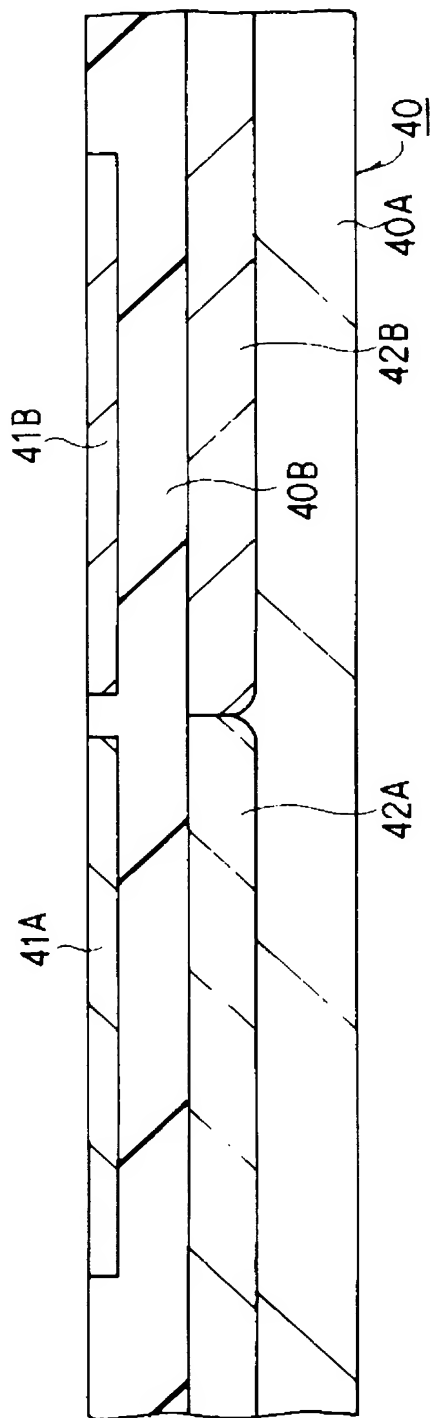
(B)



【図16】

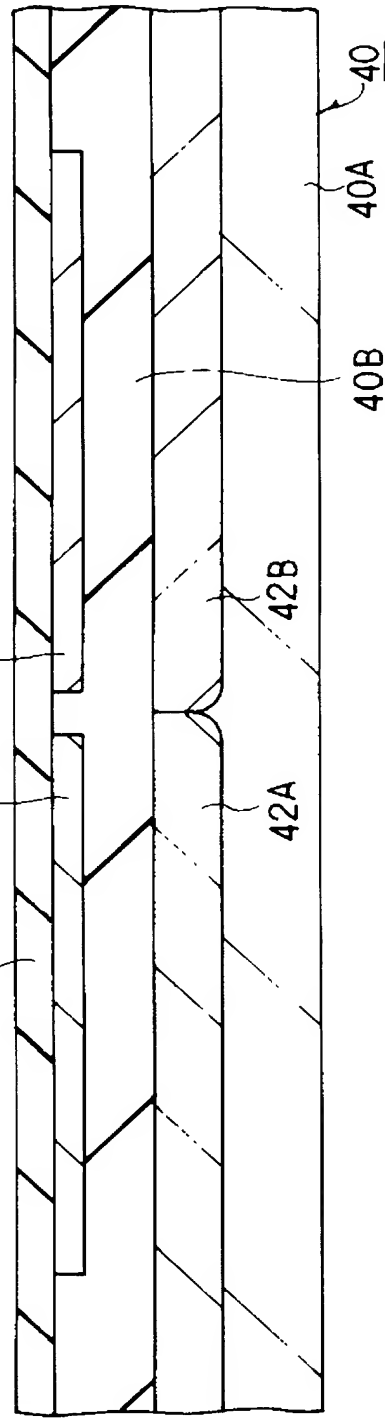
(C)

図16



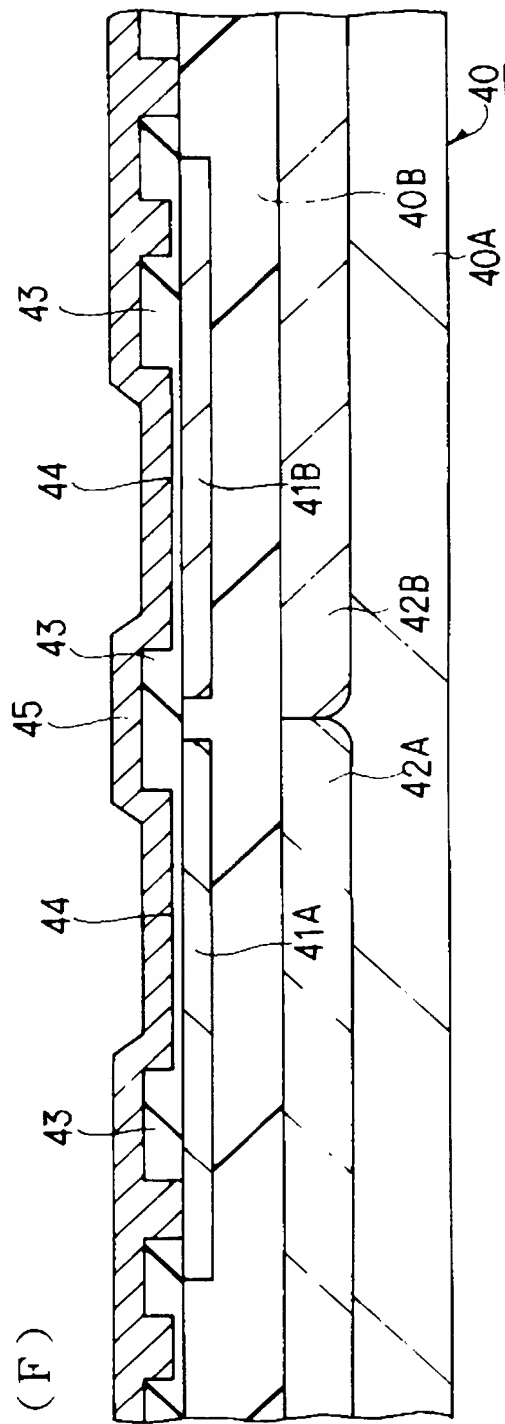
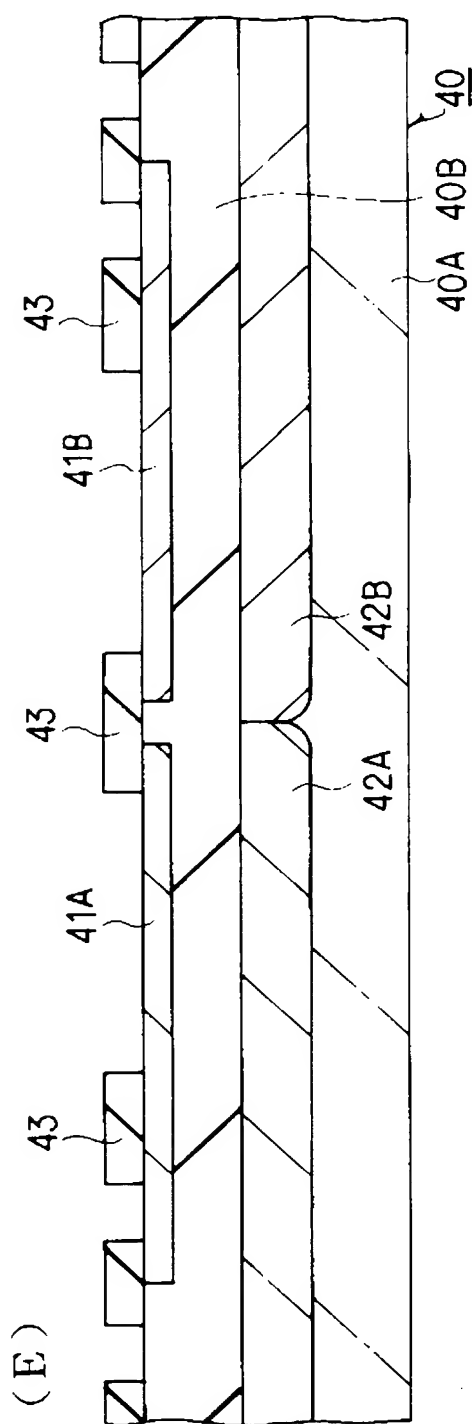
(D)

43 41A 41B



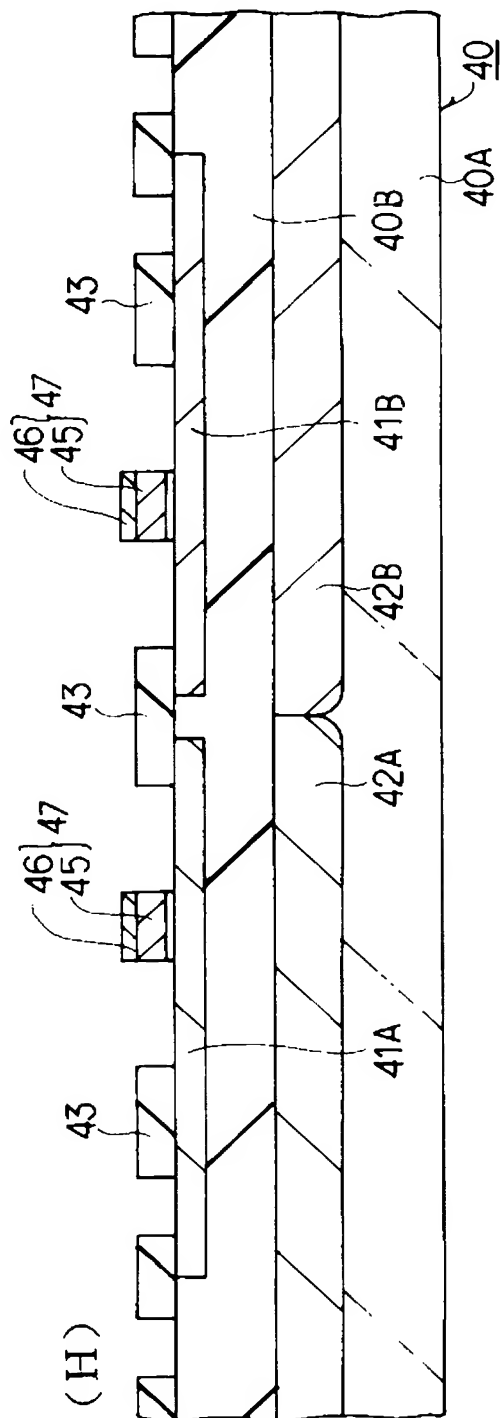
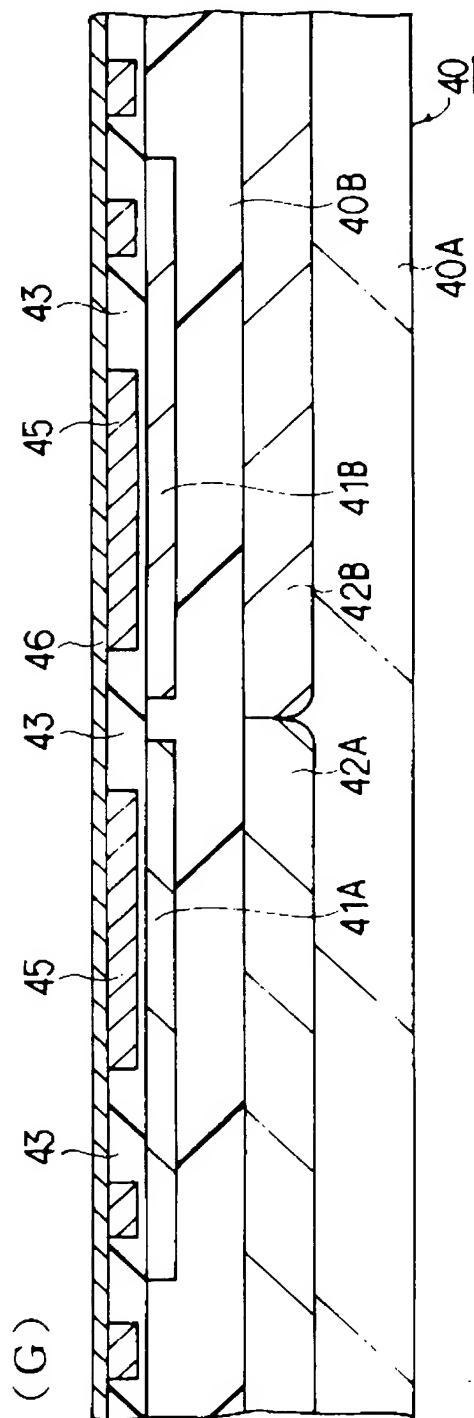
【図17】

図17

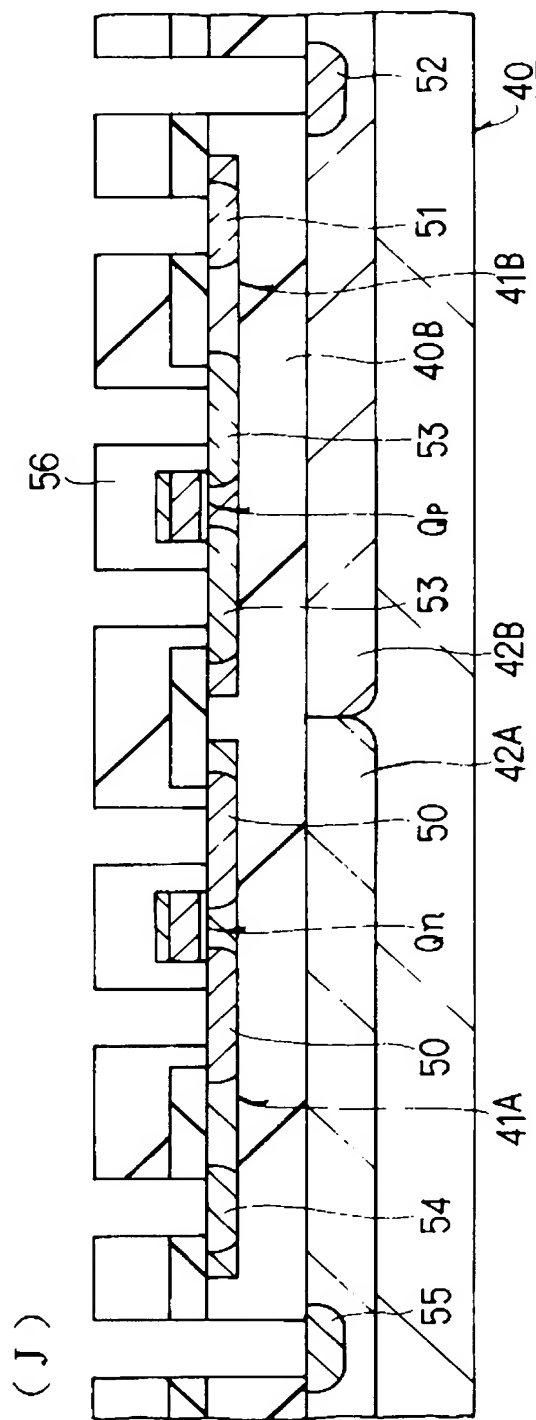
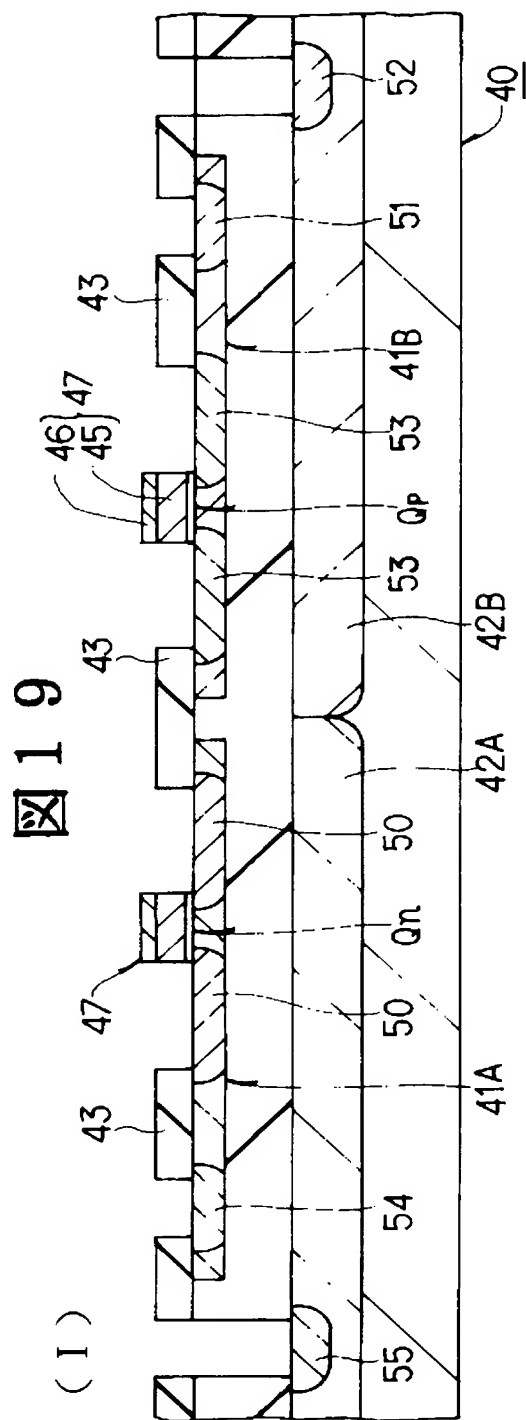


【図18】

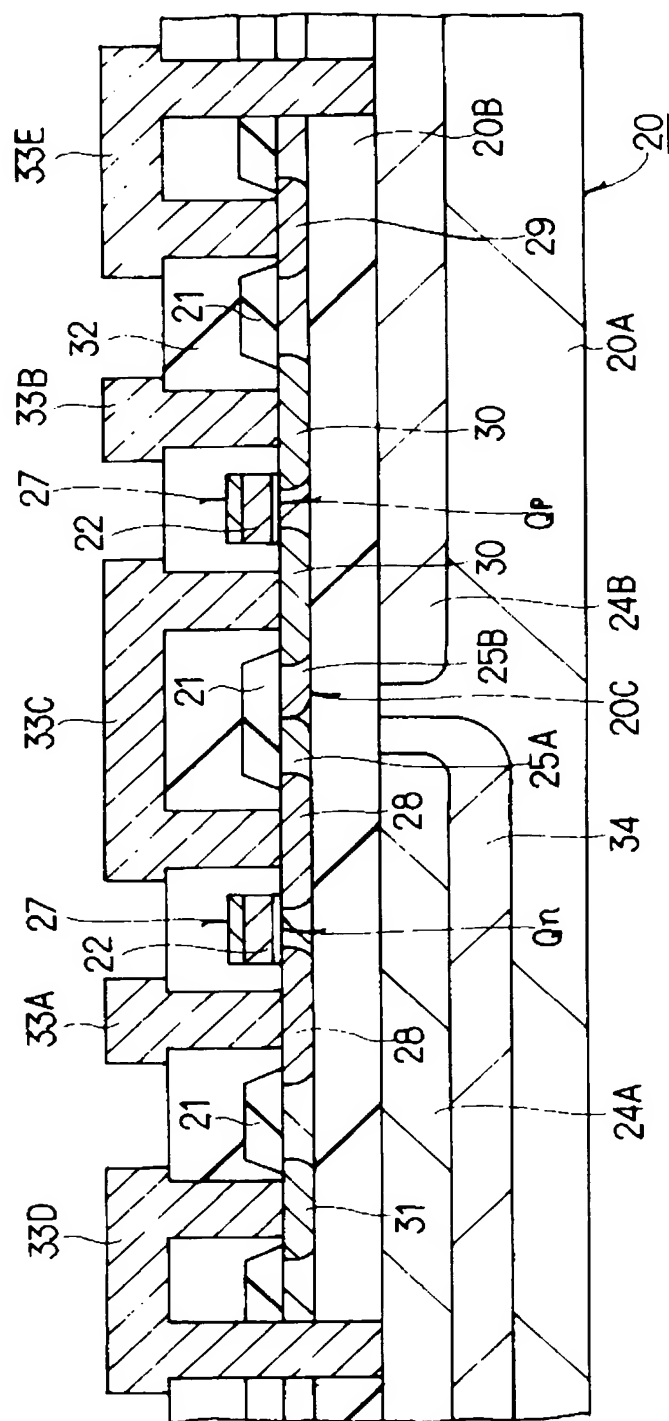
図18



【|×| 1 9】



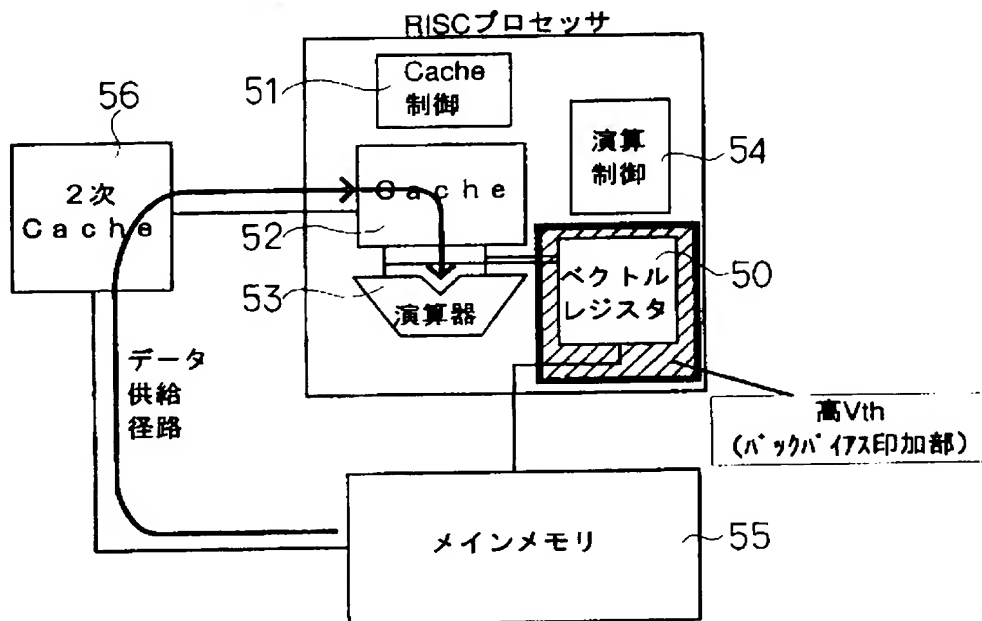
20



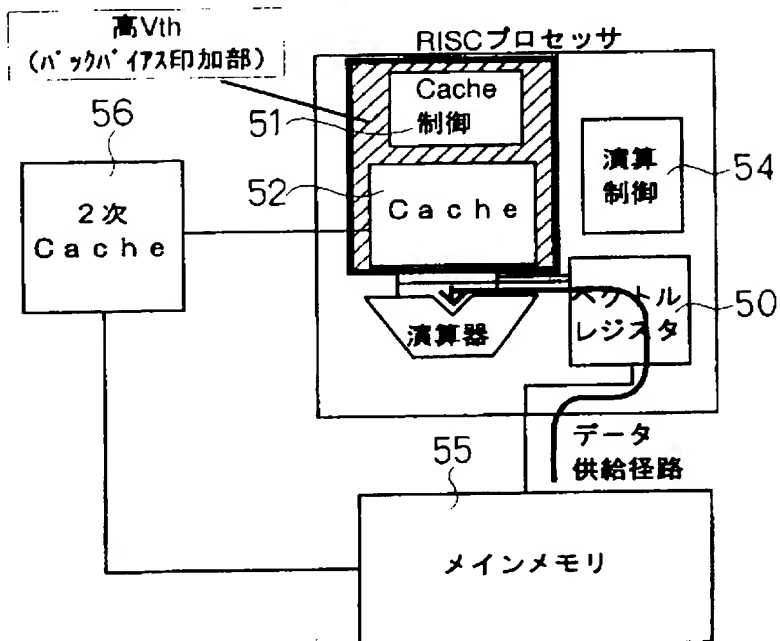
【図21】

図 21

(1) 通常動作モード

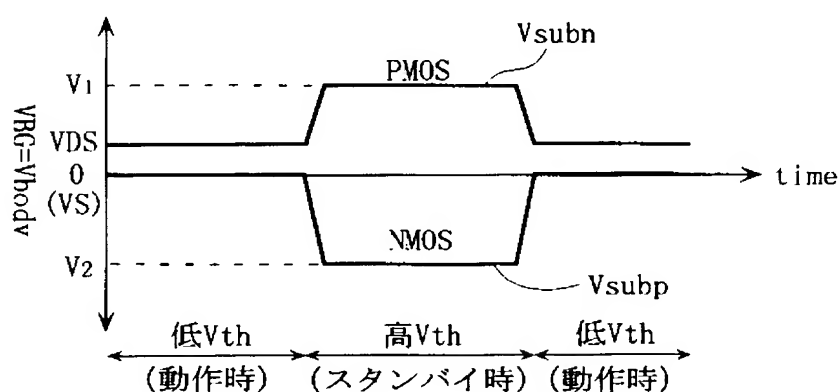


(2) 大量データ数値計算モード
(ベクトル演算モード)



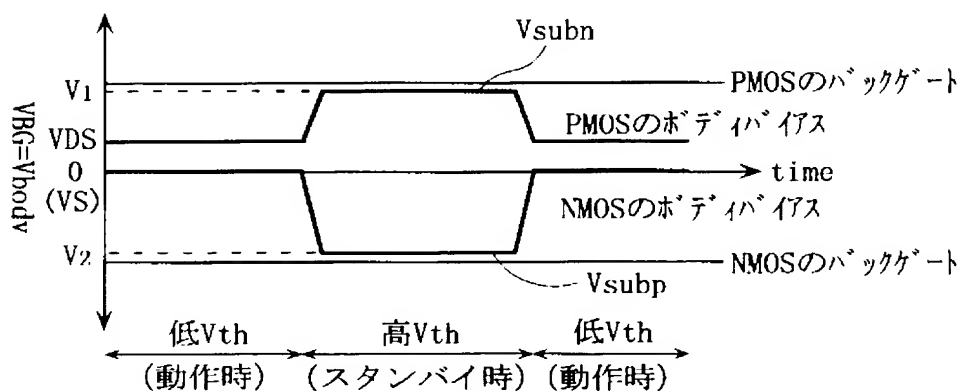
【図 2 2】

図 2 2



【図 2 3】

図 2 3



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 絶縁層上の半導体層に構成された電界効果トランジスタのドレイン耐圧が低くなる。また、閾値電圧が不安定になる。